

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年5月27日(2010.5.27)

【公開番号】特開2008-294060(P2008-294060A)

【公開日】平成20年12月4日(2008.12.4)

【年通号数】公開・登録公報2008-048

【出願番号】特願2007-135488(P2007-135488)

【国際特許分類】

H 05 K 3/18 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/18 A

【手続補正書】

【提出日】平成22年4月13日(2010.4.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基材上に導体層を形成する導体層の形成方法であって、

ポリイミド前駆体樹脂と、金属化合物と、粘度調整剤としての含窒素複素環化合物とを含有する導体層形成用組成物を塗布液として前記基材の表面に塗布し、乾燥して塗布膜を形成する塗布膜形成工程と、

前記塗布膜を、ホウ素化合物を含む還元剤溶液に浸漬して前記塗布膜中に存在する金属イオンを還元し、前記塗布膜の表面に前記導体層としての金属析出層を形成する還元工程と、

前記金属析出層を核として、無電解めっきおよび/または電気めっきを行うめっき工程と、

熱処理を行って前記塗布膜中の前記ポリイミド前駆体樹脂をイミド化してポリイミド樹脂層を形成するイミド化工程と、

を含むことを特徴とする導体層の形成方法。

【請求項2】

前記含窒素複素環化合物が、第3級アミノ化合物であることを特徴とする請求項1に記載の導体層の形成方法。

【請求項3】

前記含窒素複素環化合物が、置換または非置換の、ピリジンまたはイミダゾールであることを特徴とする請求項1に記載の導体層の形成方法。

【請求項4】

前記塗布膜形成工程では、前記導体層形成用組成物を細線状に塗布することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の導体層の形成方法。

【請求項5】

前記金属化合物が、金属種としてニッケルを含有する化合物であることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の導体層の形成方法。

【請求項6】

請求項1から5のいずれか1項に記載の導体層の形成方法によって基材上に導体層を形成する工程を含む回路基板の製造方法。